# 技术标准和要求

**1、货物需求一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **单位** | **数量** |
| 1 | CAN控制器 | 个 | 100 |
| 2 | CAN收发器 | 个 | 100 |
| 3 | ESD保护器 | 个 | 100 |
| 4 | EEROM | 个 | 100 |
| 5 | FPGA | 个 | 100 |
| 6 | PCB安装模块 | 个 | 200 |
| 7 | PCB安装模块 | 个 | 200 |
| 8 | PCB接线盒子 | 个 | 900 |
| 9 | PCB连接端子 | 个 | 200 |
| 10 | SDRAM | 个 | 100 |
| 11 | TVS | 个 | 100 |
| 12 | TVS | 个 | 100 |
| 13 | 拨码开关 | 个 | 800 |
| 14 | 薄膜电阻 | 个 | 5000 |
| 15 | 薄膜电阻 | 个 | 2000 |
| 16 | 薄膜电阻 | 个 | 2000 |
| 17 | 薄膜电阻 | 个 | 2000 |
| 18 | 薄膜电阻 | 个 | 2000 |
| 19 | 薄膜电阻 | 个 | 2000 |
| 20 | 薄膜电阻 | 个 | 2000 |
| 21 | 磁珠 | 个 | 500 |
| 22 | 电机驱动芯片 | 个 | 1000 |
| 23 | 电流采样电阻 | 个 | 3000 |
| 24 | 电源模块 | 个 | 100 |
| 25 | 电源芯片 | 个. | 100 |
| 26 | 电源芯片 | 个. | 100 |
| 27 | 电源芯片 | 个 | 100 |
| 28 | 电源芯片 | 个 | 100 |
| 29 | 电阻阵列 | 个 | 100 |
| 30 | 电阻阵列 | 个 | 1600 |
| 31 | 发光管 | 个 | 900 |
| 32 | 复位芯片 | 个 | 100 |
| 33 | 高压薄膜电阻 | 个 | 100 |
| 34 | 高压陶瓷电容 | 个 | 200 |
| 35 | 隔离芯片 | 个 | 1500 |
| 36 | 功率电感 | 个 | 200 |
| 37 | 功率电感 | 个 | 200 |
| 38 | 整流二极管 | 个 | 200 |
| 39 | 共模扼流圈 | 个 | 100 |
| 40 | 精密薄膜电阻 | 个 | 500 |
| 41 | 精密薄膜电阻 | 个 | 500 |
| 42 | 精密薄膜电阻 | 个 | 500 |
| 43 | 精密薄膜电阻 | 个 | 500 |
| 44 | 铝电解电容 | 个 | 1600 |
| 45 | 配置芯片 | 个 | 100 |
| 46 | 三极管 | 个 | 200 |
| 47 | 施密特反相器 | 个 | 400 |
| 48 | 钽电容 | 个 | 200 |
| 49 | 钽电容 | 个 | 200 |
| 50 | 陶瓷电容 | 个 | 300 |
| 51 | 陶瓷电容 | 个 | 300 |
| 52 | 陶瓷电容 | 个 | 20000 |
| 53 | 陶瓷电容 | 个 | 3000 |
| 54 | 陶瓷电容 | 个 | 3000 |
| 55 | 陶瓷电容 | 个 | 500 |
| 56 | 陶瓷电容 | 个 | 300 |
| 57 | 陶瓷电容 | 个 | 300 |
| 58 | 陶瓷电容 | 个 | 3000 |
| 59 | 陶瓷电容 | 个 | 300 |
| 60 | 陶瓷电容 | 个 | 1000 |
| 61 | 陶瓷电容 | 个 | 600 |
| 62 | 陶瓷电容 | 个 | 300 |
| 63 | 陶瓷电容 | 个 | 300 |
| 64 | 陶瓷电容 | 个 | 300 |
| 65 | 陶瓷电容 | 个 | 300 |
| 66 | 无源晶振 | 个 | 100 |
| 67 | 压敏电阻 | 个 | 200 |
| 68 | 有源晶振 | 个 | 200 |
| 69 | TVS | 个 | 100 |
| 70 | 陶瓷电容 | 个 | 5000 |
| 71 | 陶瓷电容 | 个 | 5000 |
| 72 | 陶瓷电容 | 个 | 5000 |
| 73 | 陶瓷电容 | 个 | 5000 |
| 74 | 陶瓷电容 | 个 | 5000 |
| 75 | 陶瓷电容 | 个 | 5000 |
| 76 | 陶瓷电容 | 个 | 5000 |
| 77 | 陶瓷电容 | 个 | 5000 |
| 78 | 陶瓷电容 | 个 | 5000 |
| 79 | 陶瓷电容 | 个 | 5000 |
| 80 | 陶瓷电容 | 个 | 5000 |
| 81 | 陶瓷电容 | 个 | 5000 |
| 82 | 陶瓷电容 | 个 | 5000 |
| 83 | 电机排线和接头 | 个 | 1600 |

**2、技术标准和要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **详细技术指标及功能需求** |
| 1 | CAN控制器 | MCP2515T-E/SO(扩展级，宽供电轨道，无铅) 工作环境温度-40℃ to +125℃ |
| 2 | CAN收发器 | MCP2551T-E/SO(扩展级，宽供电轨道，无铅) 工作环境温度-40℃ to +125℃ |
| 3 | ESD保护器 | PESD1CAN（工作环境温度 -65℃ to +150℃） |
| 4 | EEROM | 24LC08BT-E/ST（工业级，宽供电轨道，无铅 工作环境温度-40℃ to +125℃） |
| 5 | FPGA | EP3C55F484A7N（军用级，宽供电轨道，无铅） |
| 6 | PCB安装模块 | 2Pin 5.08mm 公母一对，额定电流大于10A（工作环境温度大于85℃） |
| 7 | PCB安装模块 | 5Pin 5.08mm 公母一对，额定电流大于5A（工作环境温度大于85℃） |
| 8 | PCB接线盒子 | 5\*2Pin 2.54mm 额定电流大于5A（工作环境温度大于85℃） |
| 9 | PCB连接端子 | 20\*2Pin 2.54mm 公母一对，额定电流大于5A（工作环境温度大于85℃） |
| 10 | SDRAM | IS45S16100E-7TLA2 (汽车级，宽供电轨道，无铅工作环境温度-40℃ to +105℃) |
| 11 | TVS | 1.5SMC36AT3G（工作环境温度 -65℃ to +150℃） |
| 12 | TVS | ESD5Z7.0T1G（工作环境温度 -55℃ to +150℃） |
| 13 | 拨码开关 | 5 Pin 8\*4mm 2mm 军品级 耐高温（200℃）触点镀金，可靠动作次数大于105 |
| 14 | 薄膜电阻 | 10KΩ,1‰精度,0.125W，英制0402封装（工作环境温度-55~+155°C） |
| 15 | 薄膜电阻 | 1KΩ,1‰精度,0.125W，英制0402封装（工作环境温度-55~+155°C） |
| 16 | 薄膜电阻 | 220Ω,1‰精度,0.125W，英制0402封装（工作环境温度-55~+155°C） |
| 17 | 薄膜电阻 | 25Ω,1‰精度,0.125W，英制0402封装（工作环境温度-55~+155°C） |
| 18 | 薄膜电阻 | 4.7KΩ,1‰精度,0.125W，英制0402封装（工作环境温度-55~+155°C） |
| 19 | 薄膜电阻 | 5.1KΩ,1‰精度,0.125W，英制0402封装（工作环境温度-55~+155°C） |
| 20 | 薄膜电阻 | 560Ω,1‰精度,0.125W，英制0402封装（工作环境温度-55~+155°C） |
| 21 | 磁珠 | 65Ω@25MHz 98Ω@100MHz，英制4020封装 直流电流大于5A，工作环境温度大于85℃ 高度低于8mm |
| 22 | 电机驱动芯片 | A4982 SLPTR-T(军用级，宽供电轨道，无铅)（工作环境温度 -55℃ to +150℃） |
| 23 | 电流采样电阻 | 1MΩ,1%精度,0.125W，英制1210封装，耐压大于2kV，脉冲电流耐量大于10A |
| 24 | 电源模块 | B0305M-1W（高效率，宽输入轨道） |
| 25 | 电源芯片 | LM25576MHX/NOPB(军用级，宽供电轨道，高效率，高精度，低负载调节率，无铅)工作环境温度-40℃ to +125℃ |
| 26 | 电源芯片 | LM2853MHX-1.2/NOPB(军用级，宽供电轨道，高效率，高精度，低负载调节率，无铅) |
| 27 | 电源芯片 | LM2853MHX-3.3/NOPB(军用级，宽供电轨道，高效率，高精度，低负载调节率，无铅) |
| 28 | 电源芯片 | LP5900SD-2.5/NOPB(军用级，宽供电轨道，极高效率，极高精度，极低负载调节率，无铅) |
| 29 | 电阻阵列 | 4.7KΩ,4通道,1% 精度，英制0804封装（工作环境温度-55~+155°C） |
| 30 | 电阻阵列 | 47Ω,4通道,1% 精度，英制0804封装（工作环境温度大-55~+155°C） |
| 31 | 发光管 | 绿色LED，英制0805封装（工作环境温度大于85℃） |
| 32 | 复位芯片 | CAT823STDI-GT3（工作环境温度 -65℃ to +150℃） |
| 33 | 高压薄膜电阻 | 1MΩ,1%精度,0.125W，英制1210封装，耐压大于2kV，脉冲电流耐量大于10A |
| 34 | 高压陶瓷电容 | 0.1uF/1KV 军品级 英制1210封装耐压大于2kV，脉冲电流耐量大于10A |
| 35 | 隔离芯片 | ADUM1411BRWZ(军用级，宽供电轨道，10M波特率，无铅)（工作环境温度 -40℃ to +105℃） |
| 36 | 功率电感 | 15uH，4A（额定），带屏蔽，尺寸10\*10mm（工作环境温度大于85℃） |
| 37 | 功率电感 | 6.8uH，4A（额定）带屏蔽，尺寸8\*8mm（工作环境温度大于85℃） |
| 38 | 整流二极管 | MBRD360T4G （工作环境温度 -65℃ to +175℃） |
| 39 | 共模扼流圈 | B82793S0513N201（截止频率10MHz，耐压大于100V，工作环境温度大于85℃） |
| 40 | 精密薄膜电阻 | 15.4KΩ, 1‰精度,0.125W，英制0402封装（工作环境温度-55~+155°C） |
| 41 | 精密薄膜电阻 | 20.5KΩ, 1‰精度,0.125W，英制0402封装（工作环境温度-55~+155°C） |
| 42 | 精密薄膜电阻 | 4.99KΩ, 1‰精度,0.125W，英制0402封装（工作环境温度-55~+155°C） |
| 43 | 精密薄膜电阻 | 499KΩ, 1‰精度,0.125W，英制0402封装（工作环境温度-55~+155°C） |
| 44 | 铝电解电容 | 100uF/50V 军品级 直径<12mm，高度<10mm |
| 45 | 配置芯片 | EPCS16SA8N（军用级，宽供电轨道，无铅） |
| 46 | 三极管 | BC846（工作环境温度 -65℃ to +150℃） |
| 47 | 施密特反相器 | SN54HC14（军用级，宽供电轨道，无铅） |
| 48 | 钽电容 | 150uF/10V 军用级，工作环境温度-40℃ to +125℃ |
| 49 | 钽电容 | 220uF/10V 军用级，工作环境温度-40℃ to +125℃ |
| 50 | 陶瓷电容 | 0.01uF 50V X7R 10%精度，英制0402封装（工作环境温度-55℃-125℃） |
| 51 | 陶瓷电容 | 0.022uF 100V X7R 10%精度，英制0402封装（工作环境温度-55℃-125℃） |
| 52 | 陶瓷电容 | 0.1uF 25V X7R 10%精度，英制0402封装（工作环境温度-55℃-125℃） |
| 53 | 陶瓷电容 | 0.22uF 16V X5R 10%精度，英制0402封装（工作环境温度-55℃-85℃） |
| 54 | 陶瓷电容 | 0.47uF 25V X5R 10%精度，英制0402封装（工作环境温度-55℃-85℃） |
| 55 | 陶瓷电容 | 10uF 6.3V X5R 20%精度，英制0402封装（工作环境温度-55℃-85℃） |
| 56 | 陶瓷电容 | 15pF 50V C0G 5%精度，英制0402封装（工作环境温度-55℃-125℃） |
| 57 | 陶瓷电容 | 180pF 50V C0G 5%精度，英制0402封装（工作环境温度-55℃-125℃） |
| 58 | 陶瓷电容 | 1nF 50V C0G 5%精度，英制0402封装（工作环境温度-55℃-125℃） |
| 59 | 陶瓷电容 | 1uF 16V X5R 10%精度，英制0402封装（工作环境温度-55℃-85℃） |
| 60 | 陶瓷电容 | 2.2uF 10V X5R 20%精度，英制0402封装（工作环境温度-55℃-85℃） |
| 61 | 陶瓷电容 | 220pF 50V C0G 50%精度，英制0402封装（工作环境温度-55℃-125℃） |
| 62 | 陶瓷电容 | 22uF 16V X5R 10%精度，英制0402封装（工作环境温度-55℃-125℃） |
| 63 | 陶瓷电容 | 4.7uF 6.3V X5R 20%精度，英制0402封装（工作环境温度-55℃-85℃） |
| 64 | 陶瓷电容 | 4.7uF 6.3V X5R 20%精度，英制0402封装（工作环境温度-55℃-85℃） |
| 65 | 陶瓷电容 | 47nF 50V X7R 10%精度，英制0402封装（工作环境温度-55℃-125℃） |
| 66 | 无源晶振 | 20 MHz 3.3V 军用级 尺寸小于3\*3mm（工作环境温度大于85℃） |
| 67 | 压敏电阻 | SIOV-CT1206K30G（工作环境温度-55~+125°C） |
| 68 | 有源晶振 | 50 MHz 3.3 V 军用级 尺寸小于5\*5mm，抖动小于28ps，前后沿小于3ns （工作环境温度大于85℃） |
| 69 | TVS | 1SMB36AT3G 脉冲功率耐量大于600W,电流耐量大于20A，（工作环境温度 -65℃ to +150℃） |
| 70 | 陶瓷电容 | 22pF 50V C0G 5%精度，英制0402封装（工作环境温度-55℃-125℃） |
| 71 | 陶瓷电容 | 33pF 50V C0G 5%精度，英制0402封装（工作环境温度-55℃-125℃） |
| 72 | 陶瓷电容 | 47pF 50V C0G 5%精度，英制0402封装（工作环境温度-55℃-125℃） |
| 73 | 陶瓷电容 | 100pF 50V C0G 5%精度，英制0402封装（工作环境温度-55℃-125℃） |
| 74 | 陶瓷电容 | 150pF 50V C0G 5%精度，英制0402封装（工作环境温度-55℃-125℃） |
| 75 | 陶瓷电容 | 330pF 50V C0G 5%精度，英制0402封装（工作环境温度-55℃-125℃） |
| 76 | 陶瓷电容 | 470pF 50V C0G 5%精度，英制0402封装（工作环境温度-55℃-125℃） |
| 77 | 陶瓷电容 | 1nF 50V C0G 5%精度，英制0402封装（工作环境温度-55℃-125℃） |
| 78 | 陶瓷电容 | 2.2nF 50V X5R 10%精度，英制0402封装（工作环境温度-55℃-85℃） |
| 79 | 陶瓷电容 | 3.3nF 50V X5R 10%精度，英制0402封装（工作环境温度-55℃-85℃） |
| 80 | 陶瓷电容 | 4.7nF 50V X5R 10%精度，英制0402封装（工作环境温度-55℃-85℃） |
| 81 | 陶瓷电容 | 10nF 50V X5R 10%精度，英制0402封装（工作环境温度-55℃-85℃） |
| 82 | 陶瓷电容 | 15nF 50V X5R 10%精度，英制0402封装（工作环境温度-55℃-85℃） |
| 83 | 电机排线和接头 | 10core 排线，20CM 压FC（工作环境温度大于85℃） |

**注：针对货物一览表中序号为4、5的贵重芯，要求供货时进行不低于5片的随机抽样检查，并提供由第三方出具的芯片检验报告，检验内容包括基本性能测试及温度等级测试，成交人需承诺最后提供抽检合格率100%的元器件。**

**3、质保及售后服务要求**

质保2年，质保期内质量问题免费更换。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的上述技术和服务要求。